1. Ключова схема на біполярному транзисторі

В інтегральних мікросхемах, виконаних на біполярних транзисторах, роль ключа виконує транзистор, включений за схемою з загальним емітером (рис. 5.1).

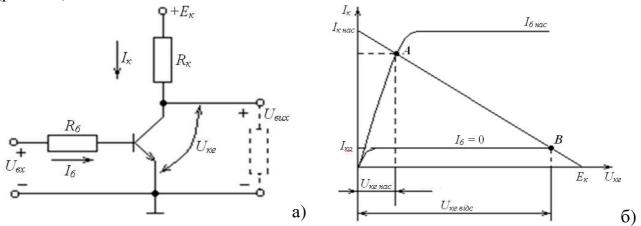


Рис. 5.1. Ключова схема на біполярному транзисторі: а – принципова схема; б – BAX ключа.

Керування станом ключа здійснюється сигналом U_{ex} . При $U_{ex}=0$, відповідно $I_{\tilde{o}}=0$ і стан схеми визначається точкою \boldsymbol{B} на ВАХ ключа. Транзистор знаходиться в стані у відсічки, що еквівалентно розімкненому ключу, а вихідна напруга U_{eux} рівна $U_{\kappa e \ ei\partial c}$, тобто є дещо меншою за E_{κ} . Струм через транзистор $I_{\kappa o}$ в цьому випадку нехтуюче малий.

При напрузі $U_{\rm ex}$, достатній для створення базового струму $I_{\rm 6\, hac}$, який переводить транзистор в режим насичення, стан схеми визначається точкою A на BAX, що рівносильно замкнутому ключу. Вихідна напруга рівна $U_{\rm ke\, hac}$, тобто ϵ трохи вищою нульового рівня, а струм через транзистор $I_{\kappa\, hac}$ максимальний і дорівнює E_{κ}/R_{κ} .

Оцінимо енергетичні затрати в ключовій схемі:

- 1. У режимі відсічки потужність, що виділяється на транзисторі і викликає його нагрівання, визначається виразом $P_{si\partial c} = U_{\kappa e \; si\partial c} \cdot I_{\kappa o}$. Унаслідок крайньої малості $I_{\kappa o}$, потужність $P_{si\partial c}$ значно менша допустимої величини.
- 2. В режимі насичення потужність $P_{\textit{hac}} = U_{\textit{ке нас}} \cdot I_{\textit{к нас}}$. Оскільки напруга $U_{\textit{ке нас}}$ мала, то $P_{\textit{нас}}$ також знаходиться в допустимих межах.
- 3. Більш детально розглянемо процес перемикання перехід ключа з одного стійкого стану в інший.

Впродовж часу перемикання τ_{ϕ} , струм $i_{\kappa}(t)$ і напруга $U_{\kappa e}(t)$ досягають відносно високих величин. На перемикання транзистора витрачається енергія

$$A_{nepem} = \int_{0}^{\tau_{\phi}} i_{\kappa}(t) U_{\kappa e}(t) dt.$$

Припустимо, що струм $i_{\kappa}(t)$ за час перемикання змінюється за лінійним законом, тобто

$$i_{\kappa}(t) = I_{\kappa \, \text{\tiny HAC}} \, \frac{t}{\tau_{\phi}} \, .$$

Використовуючи рівняння динамічного режиму роботи транзистора (рівняння навантажувальної прямої):

$$U_{\kappa e}(t) = E_{\kappa} - i_{\kappa}(t) R_{\kappa},$$

та враховуючи рівність $I_{\kappa \, \text{\it Hac}} \approx E_{\kappa}/R_{\kappa}$, отримаємо:

$$\begin{split} A_{nepe_{\mathcal{M}}} &= \int\limits_{0}^{\tau_{\phi}} \frac{E_{\kappa}}{R_{\kappa} \tau_{\phi}} t \Bigg(E_{\kappa} - \frac{E_{\kappa}}{R_{\kappa} \tau_{\phi}} R_{\kappa} t \Bigg) dt = \frac{E_{\kappa}^{2}}{R_{\kappa} \tau_{\phi}} \int\limits_{0}^{\tau_{\phi}} \Bigg(1 - \frac{t}{\tau_{\phi}} \Bigg) t \, dt = \\ &= \frac{E_{\kappa}^{2}}{R_{\kappa} \tau_{\phi}} \Bigg(\frac{t^{2}}{2} - \frac{t^{3}}{3\tau_{\phi}} \Bigg)_{0}^{\tau_{\phi}} = \frac{E_{\kappa}^{2}}{R_{\kappa} \tau_{\phi}} \Bigg(\frac{\tau_{\phi}^{2}}{2} - \frac{\tau_{\phi}^{3}}{3\tau_{\phi}} \Bigg) = \frac{E_{\kappa}^{2} \tau_{\phi}}{6R_{\kappa}}. \end{split}$$

Режим перемикання ϵ найбільш енергоємним режимом роботи транзисторного ключа. У цьому випадку, по мірі збільшення частоти перемикання, $P_{nерем}$ може досягати значних величин. Це призводить до необхідності прийняття додаткових заходів щодо забезпечення нормального

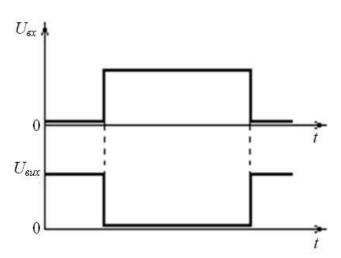


Рис. 5.2. Ідеалізована часова діаграма роботи ключа.

теплового режиму в цифрових схемах.

Ідеалізована часова діаграма (без урахування перехідних процесів) роботи ключа наведена на рис. 5.2.

Її аналіз показує, що для статичного режиму, якщо U_{ex} – низький потенціал, то U_{eux} – високий, і навпаки. Отже, найпростіша ключова схема на транзисторі з навантаженням в колі колектора, з якого знімається вихідна напруга, є інвертором, який реалізує функцію НЕ як в додатній, так і в від'ємній логіці.